



2SB1590K (3CG1590K)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于一般功率放大。

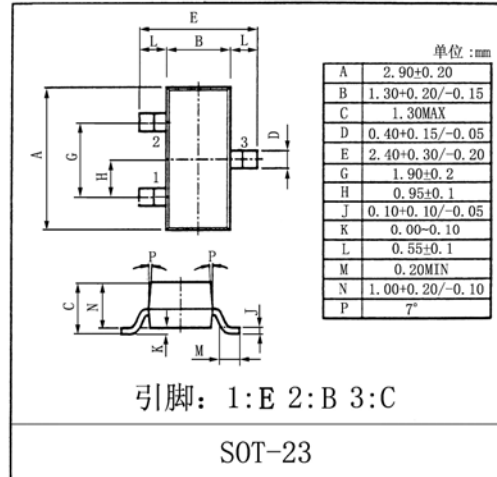
Purpose: General power amplifier applications.

特点: 低饱和压降, 大电流, 可与 2SD2444K (3DG2444K) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, large current, complementary to 2SD2444K (3DG2444K).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-15	V
V_{CE0}	-15	V
V_{EB0}	-6.0	V
I_C	-1.0	A
I_{CM}	-3.0	A
P_C	200	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-50\mu\text{A}$	-15			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$	-15			V
V_{EB0}	$I_E=-50\mu\text{A}$	-6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-12\text{V}$ $I_E=0$			-0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.5	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$	120		270	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-800\text{mA}$	80			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-0.4\text{A}$ $I_B=-20\text{mA}$			-0.3	V
f_T	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_E=50\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$		200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0\text{A}$ $f=1.0\text{MHz}$		15		pF

$h_{FE(1)}$ 分档、印章/ $h_{FE(1)}$ Classifications、Marking:

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ Classifications	Q
$h_{FE(1)}$ 范围/ $h_{FE(1)}$ Range	120~270
印章/Marking	HBKQ

